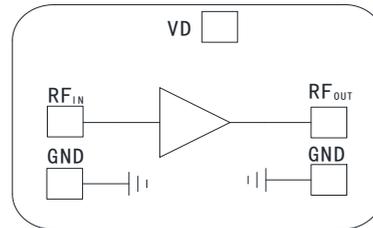


特点:

- 频率范围: 0.1~3.0GHz
- 增益: 30dB
- 噪声系数: 典型值 0.7dB
- 输出 1dB 压缩点: 典型值+19dBm
- 单电源工作: 典型值+5V/105mA
- 芯片尺寸: 1.05mm×1.25mm×0.1mm

功能框图:



产品简介:

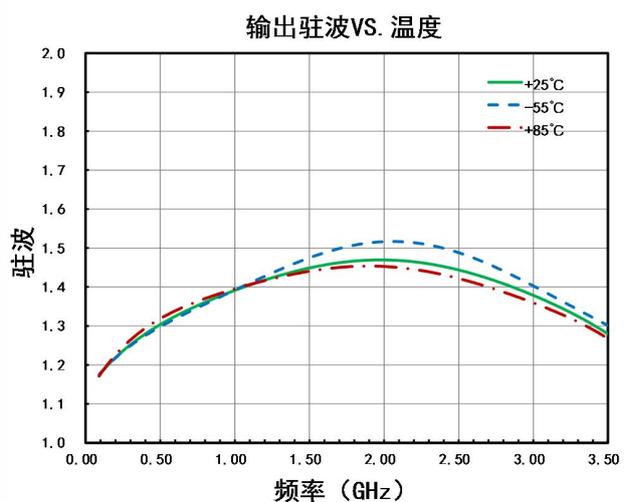
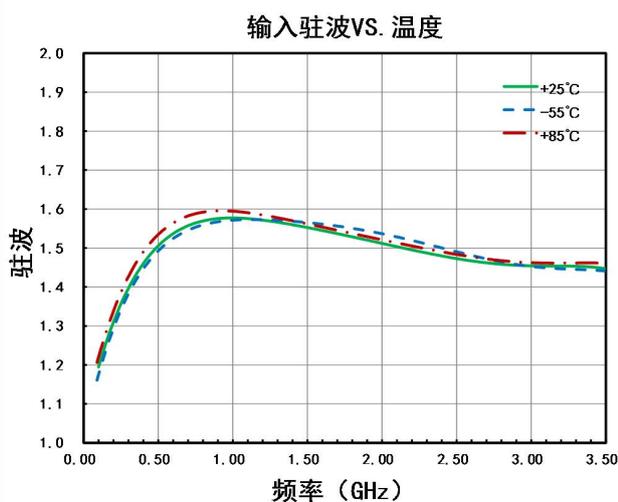
YDC1117 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

性能参数: (50Ω系统, T_A=-55°C~+85°C)

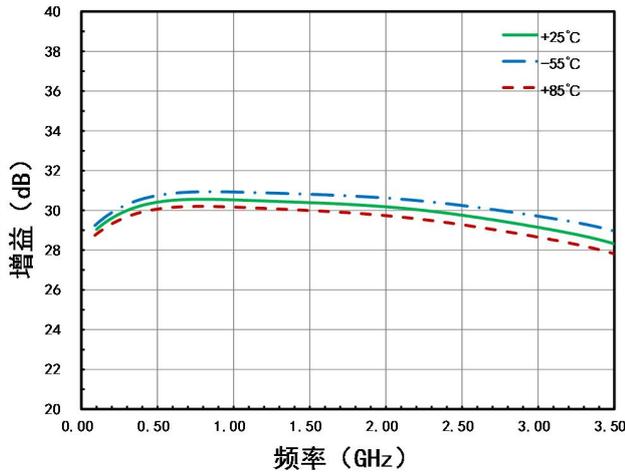
参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	0.1	-	3.0	GHz
增益	G	-	30	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	±0.7	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.5	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.4	-	-
噪声系数	NF	-	0.7	-	dB
反向隔离度	IR	-	42	-	dB
输出 P-1dB	OP _{1dB}	-	+19	-	dBm
输出 IP ₃ *	OIP ₃	-	+28	-	dBm
电源电压	V _{dd}	-	+5	-	V
工作电流	I _{dd}	-	105	-	mA

*: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

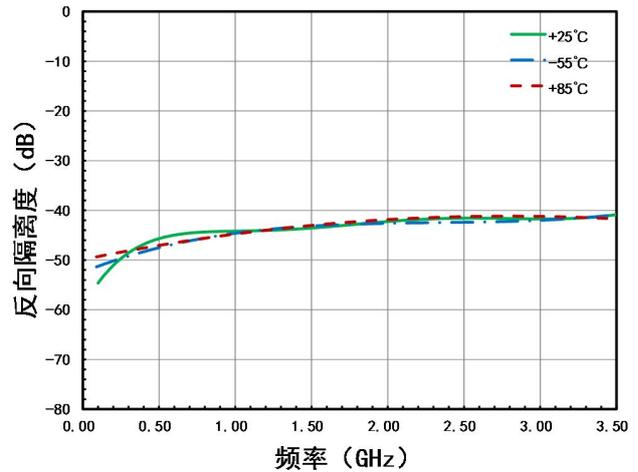
典型测试曲线: (50Ω系统, V_{dd}=+5V, I_{dd}=105mA, 夹具测试)



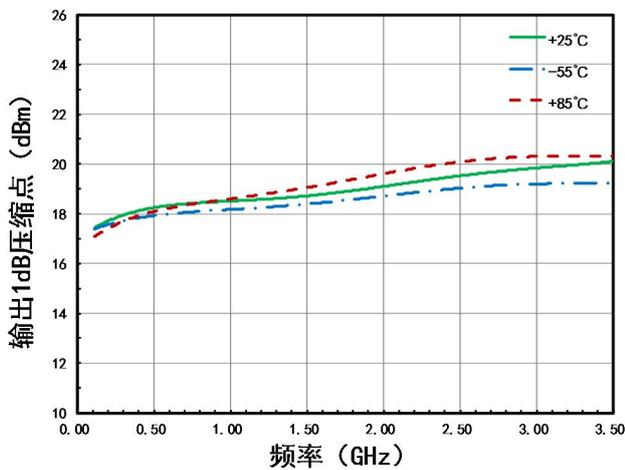
增益VS. 温度



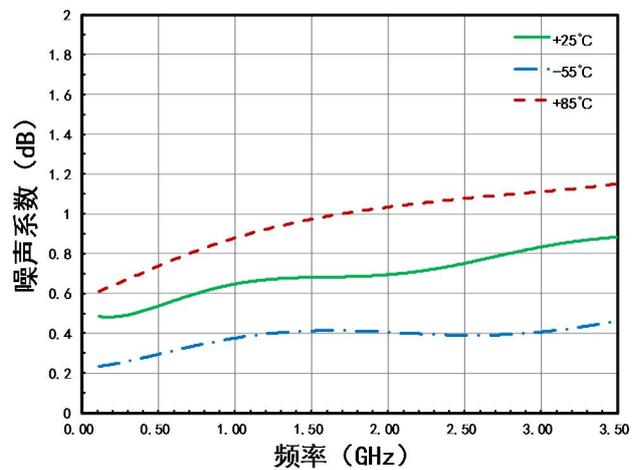
反向隔离度VS. 温度



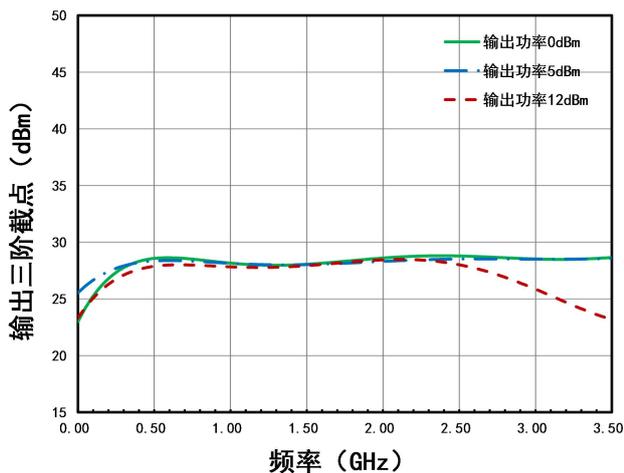
输出1dB压缩点VS. 温度



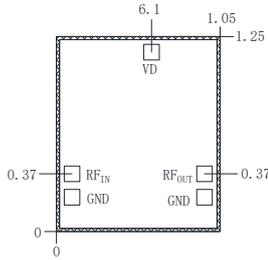
噪声系数VS. 温度



输出三阶截点VS. 频率(+25°C)



外形尺寸图:

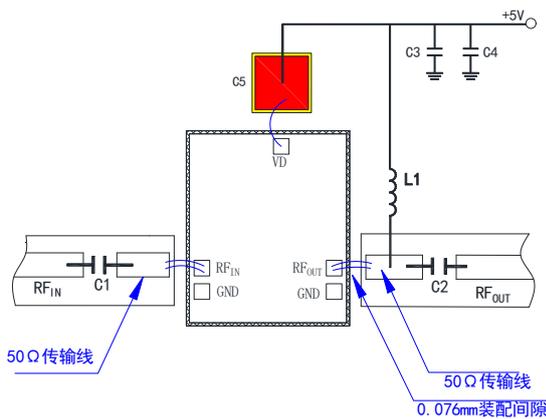


注: 1.单位: mm;

- 2.芯片背面镀金, 背面接地;
- 3.外形尺寸公差: $\pm 0.05\text{mm}$;
- 4.键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1 \times 0.1\text{mm}$ 。



推荐装配图:



注: 射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸, 典型的装配间隙是 0.076~0.152mm, 使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400 μm 。

产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆, 芯片表面容易受损, 不能用干或湿化学方法清洁芯片表面, 使用时须小心。
3. 芯片粘接装配时, 需考虑热膨胀应力对芯片的影响, 芯片建议烧结或粘接在热膨胀系数相近的载体上, 如可伐、钨铜或钼铜垫片上, 避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C , 时间不能超过 20 秒), 使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 $25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 0.25~0.40mm (10~16 mils)。
6. 在存储和使用过程中注意防静电, 烧结、键合台接地良好。

引脚定义:

符号	描述
RF _{IN}	射频输入, 芯片内部无隔直
RF _{OUT}	射频输出, 芯片内部无隔直
VD	电源端口, +5V 供电
GND/芯片背面	接地, 芯片底部需接地良好

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率, 50 Ω	+18dBm
电源电压	+6V
装配温度	+300 $^\circ\text{C}$, 20s
工作温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$
贮存温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

推荐应用电路器件值:

频率 编号	0.1~0.6GHz	1~3GHz	0.1~3GHz	备注
	推荐值			
C1、C2	10nF	100pF	1000pF	
C3	10nF	10nF	10nF	
C4	4.7uF	4.7uF	4.7uF	
C5	100pF	100pF	100pF	芯片电容
L1	270nH	56nH	100MHz@1800 Ω 磁珠	电流 > 150mA

注: 电容、电感、磁珠可根据实际使用频段选用。